



Maßbild mit Anschlußbelegung

Wärmewiderstände: $R_{thja} \leq 125 \text{ K/W}^1)$

$R_{thjc} \leq 10 \text{ K/W}$

SCE 535/537/539-npn-, SCE 536/538/540-pnp- Silizium-Epitaxie-Planar-NF-Transistoren für allgemeine Anwendungen in der Hybrid- und Aufsetztechnik

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
$ U_{CBO} $	45	60	100	V
$ U_{CEO} $	45	60	80	V
$ U_{EBO} $	5	5	5	V
$ I_C $	1	1	1	A
$ I_{CM} $	1,5	1,5	1,5	A
$ I_B $	0,2	0,2	0,2	A
P_{tot} ($T_a = 25 \text{ °C}$) ¹⁾	1	1	1	W
T_j	150	150	150	°C
T_a	-55 bis 125	-55 bis 125	-55 bis 125	°C

1) Transistor auf Keramiksubstrat 0,7 cm dick, 2,5 cm² Fläche

Statische Kennwerte ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
$ U_{(BR)CBO} $ ($ I_C = 1 \text{ mA}$)	45	60	100	V
$ U_{(BR)CEO} $ ($ I_C = 50 \text{ mA}$)	45	60	80	V
$ U_{(BR)EBO} $ ($ I_E = 10 \text{ } \mu\text{A}$)	5	5	5	V
$ I_{CBO} $ ($ U_{CB} = 30 \text{ V}$)	≤ 100	≤ 100	≤ 100	nA
$ U_{CEsat} $ ($ I_C = 500 \text{ mA}$, $ I_B = 50 \text{ mA}$)	≤ 500	≤ 500	≤ 500	mV
$ U_{BEsat} $ ($ I_C = 500 \text{ mA}$, $ I_B = 50 \text{ mA}$) ¹⁾	$\leq 1,3$	$\leq 1,3$	$\leq 1,3$	V
$ U_{BE} $ ($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 500 \text{ mA}$) ¹⁾	≤ 1	≤ 1	≤ 1	V
h_{21E} ($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 5 \text{ mA}$) ¹⁾	> 25	> 25	> 25	
($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 150 \text{ mA}$) ¹⁾				
Gruppe A	40 bis 100	40 bis 100	40 bis 100	
Gruppe B	63 bis 160	63 bis 160	63 bis 160	
Gruppe C	100 bis 250	100 bis 250	100 bis 250	
($ U_{CE} = 2 \text{ V}$, $ I_C = 500 \text{ mA}$) ¹⁾			1) impulsmäßige Messung, $t_p = 300 \text{ } \mu\text{s}$, $t_p/T = 0,01$	

Dynamische Kennwerte ($T_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$)

	SCE 535/536	SCE 537/538	SCE 539/540	Einheit
f_T ($ U_{CE} = 10 \text{ V}$, $ I_C = 50 \text{ mA}$, $f = 20 \text{ MHz}$)	> 50	> 50	> 50	MHz